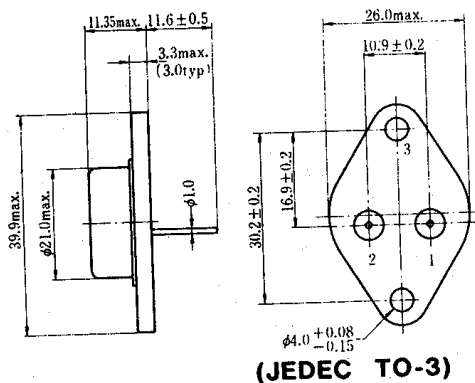


2SC1942

シリコン NPN 三重拡散形
高電圧電力スイッチング用
TV 水平偏向出力用

SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED
HIGH VOLTAGE POWER SWITCHING
TV HORIZONTAL DEFLECTION OUTPUT



1. ベース: Base
 2. エミッタ: Emitter
 3. コレクタ: Collector
- (ケース) (Case)
(Dimensions in mm)

(JEDEC TO-3)

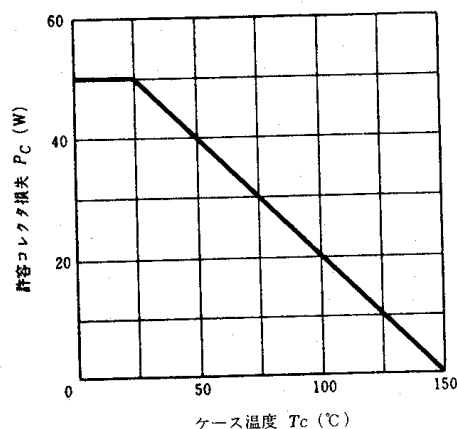
■ 絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項	目	Symbol	2SC1942	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}		1500	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}		800	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}		6	V
コレクタ電流	I_C		3	A
サージコレクタ電流	$I_{C(surge)}$		6	A
許容コレクタ損失	P_C^*		50	W
接合部温度	T_j		150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}		-45~+150	$^\circ\text{C}$

* $T_c=25^\circ\text{C}$ における許容値

* Value at $T_c=25^\circ\text{C}$

許容コレクタ損失のケース温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



■ 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項	目	Symbol	Test Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$		$I_C=10\text{mA}, R_{BE}=\infty$	800	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$		$I_E=10\text{mA}, I_C=0$	6	—	—	V
コレクタ遮断電流	I_{CBO}		$V_{CB}=600\text{V}, I_E=0$	—	—	10	μA
	I_{CBX}		$V_{CB}=1500\text{V}, V_{EB}=1.5\text{V}$	—	—	0.5	mA
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$		$I_C=2.5\text{A}, I_B=0.8\text{A}$ (Pulse Test)	—	—	5	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$		$I_C=2.5\text{A}, I_B=0.8\text{A}$ (Pulse Test)	0.8	—	1.5	V
下降時間	t_f		$I_C=2.75\text{A}, I_{B1}=0.6\text{A}, I_{B2}=-1.3\text{A}, L_B=0$	—	—	1.0	μs

■ 各特性曲線は 2SD1494 参照。

See characteristic curves of 2SD1494.